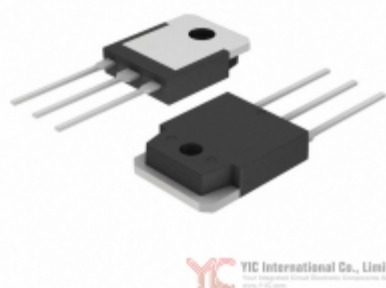



	<h2 style="color: #E67E22;">GP2M020A060N</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP2M020A060N</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 20A TO3PN
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP2M020A060N.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1698 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP2M020A060N</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A TO3PN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1698 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	347W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	330 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3184pF @ 25V
Verpackung	Tube

GP2M020A060N ist neu im Original, Suche GP2M020A060N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP2M020A060N Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP2M020A060N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>GP2S+</b> MINI MINI QFN	 <b>GP2M012A080NG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 12A TO3PN	 <b>GP2S05</b> SHARP SHARP DIP4	 <b>GP2M020A050F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 18A TO220F
 <b>GP2S1+</b> MINI	 <b>GP2M020A050N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 20A TO3PN	 <b>GP2M013A050F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 13A TO220F	 <b>GP2M020A050H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 18A TO220

### heiße Teile

Mehr

⊗ GP2A28A1J00F	↔ GP2A28N1J00F	⇒ GP2AP002A00F	D GP2AP002S00F	↔ GP2AP003A10F
⊣ GP2AP007A00F	⊗ GP2AP008T00F	D GP2AP030A00F	⇒ GP2AP052A00F	↔ GP2AP052A00F
⊗ GP2L26K2	⊣ GP2M002A060FG	⊗ GP2M004A060PG	↔ GP2M004A065FG	↔ GP2M004A065PG
D GP2M005A050PG	⊗ GP2M005A060CG	⊣ GP2M005A060FG	⊗ GP2M005A060PGH	↔ GP2M008A060FGH
⇒ GP2M010A060F	↔ GP2M010A065F	⊗ GP2M011A090NG	⊣ GP2M012A080NG	↔ GP2M020A050H
↔ GP2S24J0000F	⇒ GP2S27T3	D GP2S27T3J00F	⊗ GP2S27V6	⊣ GP2S29SVJ00F
⊗ GP2S40JJ000F	D GP2S700HCP	⇒ GP2S700HCP	↔ GP2W0004YP	↔ GP2W0110YPS
⊣ GP2W0112YPOF	⊗ GP2W0118YPS	↔ GP2W0150YP0F	⇒ GP2W3104XP0F	↔ GP2W3104YP0F
⊗ GP2W3106YP0F	⊣ GP2W3152YP0F	⊗ GP2W3172XP0F	D GP2W3270XP0F	↔ GP2Y0A02YK0F
↔ GP2Y0A02YK0F	⊗ GP2Y0A21	⊣ GP2Y0A21YK0F	⊗ GP2Y0A41SK0F	↔ GP2Y0A41SK0F

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited